

Faszination Naturwissenschaft: Finale der Landesolympiade Physik in Frankfurt (Oder)

Junge Talente brillieren bei der 34. Auflage

Frankfurt (Oder). Im diesjährigen Finale der 34. Landesolympiade Physik traten insgesamt 58 Schülerinnen und Schüler aus 18 Schulen in Brandenburg der Jahrgänge 7 bis 12 im Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium an, um ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Hierbei stellten sie sich anspruchsvollen Aufgaben wie der Untersuchung der Veränderung des Brechungsindex von Wasser durch die Zugabe von Salz, auf welche Weise ein Astronaut im Zustand der Schwerelosigkeit Wasser in einem Gefäß erhitzen kann oder der Bestimmung des Effektivwertes der Stromstärke und der Phasenverschiebung im Primärstromkreis. Nach den theoretischen Prüfungen der Fachkenntnisse sowie der Problemlösungsfähigkeiten der Nachwuchsphysikerinnen und -physiker am Mittwoch folgten am Donnerstag die Experimente. Im Anschluss besuchten die jungen Physiktalente das IHP – Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik, wo sie einen umfassenden Einblick in die Welt der Forschung erhielten. Die ebenfalls im IHP stattfindende Siegerehrung schloss die diesjährige Physikolympiade erfolgreich ab.

Am IHP begrüßte der Wissenschaftlich-Technische Geschäftsführer, Prof. Dr. Gerhard Kahmen, die Schülerinnen und Schüler: „Sie haben es geschafft: Über drei Runden haben Sie sich qualifiziert und sind ins Finale gekommen. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind der wissenschaftlich technische Nachwuchs, der gebraucht wird, um die Welt von morgen zu verändern und voranzutreiben. Physik ist die Grundlage zahlreicher Disziplinen. Seien Sie offen dafür, z. B. in den Grundlagenfächern aber auch in den Ingenieurwissenschaften. Suchen Sie den Dialog mit unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, informieren Sie sich und bleiben Sie dem Thema treu. Die Welt steht Ihnen offen.“



Blick in kleinste Welten: Die Schülerinnen und Schüler besuchten verschiedenste Labore, hier das Labor für Molekularstrahlepitaxie

© IHP 2024/Franziska Wegner

Dr. Marvin Zöllner, Leiter der Gruppe Halbleiter-Optoelektronik, führte in sein Forschungsfeld ein und erläuterte das Thema Materialentwicklung mittels Synchrotronstrahlung. Gleichzeitig ermunterte er die Jugendlichen, ihre Neigung zum Beruf zu machen. Weitere mögliche Arbeitsbereiche wurden im Anschluss bei verschiedenen Laborführungen erläutert. Im Dialog mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern konnten einige Fragen geklärt werden. Einblicke gab es unter anderem in den IHP-Reinraum, das Spektroskopie-Labor und das Tester-Labor.



Pressemitteilung



Leibniz Institute
for High
Performance
Microelectronics

Während der feierlichen Siegerehrung, die musikalisch von Cajon und E-Gitarre eingeleitet wurde, überbrachte Birgit Nix, stellvertretend für das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg, Glückwünsche und anerkennende Worte. Sie unterstrich, dass die Landesolympiade Physik einen zentralen Bestandteil zur Förderung von außergewöhnlich talentierten und begabten Schülerinnen und Schülern bildet. Dabei betonte sie ausdrücklich das unermüdliche Engagement der Lehrkräfte, die einen maßgeblichen Beitrag zur Entwicklung und Unterstützung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer leisten. Weiterhin hob sie die bedeutende Rolle des BLIS e.V. hervor, der als Träger der mathematisch-naturwissenschaftlichen Landesolympiaden eine unverzichtbare Unterstützung für die Durchführung solch anspruchsvoller Wettbewerbe darstellt.

Die gemeinsame Ausrichtung des Finales der Landesolympiade Physik geht auf den Kooperationsvertrag der beiden Einrichtungen IHP und Gauß-Gymnasium zurück. In seinem Grußwort betonte Frankfurts Bürgermeister Claus Junghanns die Verbindung der Landesolympiade zur Frankfurter Wissenschaftseinrichtung IHP. Außerdem sagte er: „Ich hoffe, dass ich einige von Ihnen und Euch vielleicht in ein paar Jahren in Frankfurt wieder sehe: In einem unserer Unternehmen, bei einem Fachtag oder an anderen Stellen.“



Die Teilnehmenden der
diesjährigen Finalrunde.
© IHP 2024/Juliane Schlegel

Die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger:

Jahrgangsstufe 7

3. Preis

Paul Eichberger und Toni Winkler vom Max-Steenbeck-Gymnasium

2. Preis

Felix Zimmer vom Max-Steenbeck-Gymnasium

1. Preis

Lorenzo Loudermilk vom Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium



Pressemitteilung



Leibniz Institute
for High
Performance
Microelectronics

Jahrgangsstufe 8

3. Preis

Paula Kruse vom Friedrich-Anton-von-Heinitz-Gymnasium und Jaron Zielhofer vom Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium

2. Preis

Elsa Lehnert vom Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium

1. Preis

Max Oramus vom Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium

Jahrgangsstufe 9

3. Preis

Finja Heller und Fabian Zimmermann vom Weinberg-Gymnasium

2. Preis

Justus Böhme vom Max-Steenbeck-Gymnasium

1. Preis

Klara Guzenda vom Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium

Jahrgangsstufe 10

3. Preis

Henrik Mengdehl vom Paulus-Praetorius-Gymnasium

2. Preis

Annika Krüger vom Albert-Schweitzer-Gymnasium

1. Preis

Jonathan Panzer vom Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium

Jahrgangsstufe 11/12

3. Preis

Vinzent Schultze vom Max-Steenbeck-Gymnasium

2. Preis

Jonathan Rajewicz vom Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium

1. Preis

Tilo Schacher vom Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium



Pressemitteilung

Ansprechpartnerin für PR:

M.A. Franziska Wegner

Public Relations

IHP GmbH – Leibniz Institute for High Performance Microelectronics/

Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik

Im Technologiepark 25

15236 Frankfurt (Oder)

Fon: +49 (335) 5625 205

E-Mail: wegner@ihp-microelectronics.com



Leibniz Institute
for High
Performance
Microelectronics

Über das IHP:

Das IHP ist ein Institut der Leibniz-Gemeinschaft und betreibt Forschung und Entwicklung zu siliziumbasierten Systemen, Höchstfrequenz-Schaltungen und -Technologien einschließlich neuer Materialien. Es erarbeitet innovative Lösungen für Anwendungsbereiche wie die drahtlose und Breitbandkommunikation, Sicherheit, Medizintechnik, Industrie 4.0, Mobilität und Raumfahrt. Das IHP beschäftigt ca. 365 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es verfügt über eine Pilotlinie für technologische Entwicklungen und die Präparation von Hochgeschwindigkeits-Schaltkreisen mit 0,13/0,25 μm -SiGe-BiCMOS-Technologien, die sich in einem 1500 m² großen Reinraum DIN EN ISO 14644-1 3 befindet.

www.ihp-microelectronics.com

